

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09269329 A

(43) Date of publication of application: 14.10.97

(51) Int. CI

G01N 37/00 G01B 11/30 G11B 9/00 G11B 11/00

(21) Application number: 08103361

(22) Date of filing: 29.03.96

(71) Applicant:

**CANON INC** 

(72) Inventor:

KURODA AKIRA SHIMADA YASUHIRO

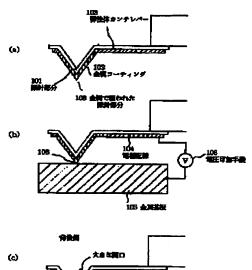
(54) METHOD OF MANUFACTURING PROBE HAVING MINUTE OPENING, COMPOSITE DEVICE OF SCANNING PROXIMITY FIELD OPTICAL MICROSCOPE AND SCANNING TUNNEL MICROSCOPE USING THE PROBE AND RECORDER/REPRODUCER USING THE PROBE

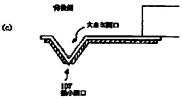
# (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To contrive improvement of yield by bringing a metal coated probe into contact with metal material, and removing the coated metal of the edge of the probe by voltage application.

SOLUTION: An elastic cantilever 102 which is metal-coated and whose edge has a sharp probe part 101 is made, a probe part 108 covered with metal is brought into contact with a metal substrate 105, electrode wiring 104 is conducted with a voltage application means 106, and voltage is impressed between the probe part 108 and the metal substrate 105. Thereby the coated metal film of the edge part of the probe is removed by electric field evaporation or heat fusion, and a minute opening 107 is formed. The diameter of the minute opening 107 can be controlled by controlling the diameter of the edge of the probe, film thickness of coating metal 103, contact force of the edge of the probe for the metal substrate 105 and a voltage application condition. It is in the range of about 10-100nm that the opening 107 can be stably formed.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO





## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-269329

(43)公開日 平成9年(1997)10月14日

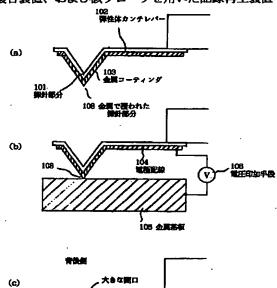
術表示箇所		
(全 13 頁)		
07		
<ul><li>(田区下丸子3丁目30番2号</li><li>(田区下丸子3丁目30番2号 キヤ</li></ul>		
2号 キヤ		
	•	

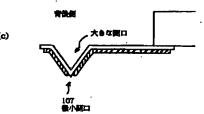
(54) 【発明の名称】 微小開口を有するプローブの作製法とそれによるプローブ、並びに該プローブを用いた走査型近接場光顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡との複合装置、および該プローブを用いた記録再生装置

# (57)【要約】

【課題】本発明は、大きさにばらつきがなく、歩留まりも良好な微小開口が短時間で容易に形成でき、集積化・小型化が可能で分解能が良好な微小開口を有するプローブの作製法とそれによるプローブ、並びに該プローブを用いた走査型近接場光顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡との複合装置、および該プローブを用いた記録再生装置を提供することを目的としている。

【解決手段】本発明は、上記課題を解決するため、走査型近接場光顕微鏡およびその原理を応用した情報記録再生装置等における先端のコーティング部に微小開口を有するプローブの作製法において、前記プローブを導電性材料でコーティングしてその先端を導電性基板に接触させ、該コーティングされたプローブと該基板との間に電圧を印加することにより、該プローブ先端のコーティング材料を除去し微小開口を形成することを特徴とする微小開口を有するプローブの作製法と、それによるプローブ、並びに該プローブを用いた走査型近接場光顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡との複合装置、および該プローブを用いた記録再生装置を構成するものである。





30

40

50

1

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】走査型近接場光顕微鏡およびその原理を応用した情報記録再生装置等における先端のコーティング部に微小開口を有するプローブの作製法において、前記プローブを導館性材料でコーティングしてその先端を導電性基板に接触させ、該コーティングされたプローブと該基板との間に電圧を印加することにより、該プローブ先端のコーティング材料を除去し微小開口を形成することを特徴とする微小開口を有するプローブの作製法。

【請求項2】前記プローブは、弾性体で形成され、または弾性体により支持され、該弾性体を弾性変形させて該プローブ先端と前記基板との間に作用する力を制御するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の微小開口を有するプローブの作製法。

【請求項3】前記プローブが、複数のプローブであり、 該複数のプローブ先端を同時に前記基板に接触させ、該 複数のプローブ先端に同時に微小開口を形成することを 特徴とする請求項1または請求項2に記載の微小開口を 有するプローブの作製法。

【請求項4】走査型近接場光顕微鏡およびその原理を応用した情報記録再生装置等における先端のコーティング部に微小開口を有するプローブにおいて、導電性材料でコーティングしたプローブ先端を導電性基板に接触させ、該コーティングされたプローブと該基板との間に電圧を印加し、該プローブ先端のコーティング材料を除去することによって形成された微小開口を有していることを特徴とするプローブ。

【請求項5】前記プローブは、光学的に透明な材料からなる探針と該探針を支持する弾性体支持部とからなり、該探針はその先端に形成された導電性コーティング薄膜に直径100 [nm] 以下の大きさの微小開口を有すると共に、該微小開口を有する該探針先端面に対する該探針の逆側面には導電性コーティング薄膜が形成されていないことを特徴とする請求項4に記載のプローブ。

【請求項6】前記プローブは、前記微小開口を光学的に 透明で導電性を有する材料で覆ったことを特徴とする請 求項4または請求項5に記載のプローブ。

【請求項7】前記光学的に透明で導電性を有する材料が、ITOであることを特徴とする請求項6に記載のプローブ。

【請求項8】前記光学的に透明で導電性を有する材料が、ポリジアセチレンであることを特徴とする請求項6に記載のプローブ。

【請求項9】プローブと、該プローブ先端におもて面を 対向して配置された試料と、該試料の裏面に光を照射す る手段と、該プローブの微小開口を通った光の強度を検 出する手段と、該試料面内で該対向方向と垂直な方向に 該プローブと該試料とを相対移動させる手段とを有する 走査型近接場光顕微鏡において、

前記プローブが請求項4または請求項5に記載のプロー

ブで構成されていることを特徴とする走査型近接場光顕 微鏡。

【請求項10】前記光強度検出手段が、前記プローブの 微小開口の背後に位置するよう該プローブを支持する部 材と一体に構成されていることを特徴とする請求項9記 載の走査型近接場光顕微鏡。

【請求項11】前記プローブが、複数のプローブであり、前記光強度検出手段が該複数プローブの微小開口を通った光をそれぞれ独立に検出する複数の光強度検出手段であることを特徴とする請求項9に記載の走査型近接場光顕微鏡。

【請求項12】プローブと、該プローブ先端におもて面を対向して配置された試料と、該試料の裏面に光を照射する手段と、該プローブの微小開口を通った光の強度を検出する手段と、該プローブ先端と該試料との間に流れる電流を検出する手段と、該試料面内で該対向方向と垂直な方向に該プローブと該試料とを相対移動させる手段とを有する走査型近接場光顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡との複合装置において、

20 前記プローブが請求項6に記載のプローブで構成されて いることを特徴とする走査型近接場光顕微鏡と走査型ト ンネル顕微鏡との複合装置。

【請求項13】前記光検出手段が、前記プローブの微小 開口の背後に位置するよう該プローブを支持する部材と 一体構成されていることを特徴とする請求項12に記載 の走査型近接場光顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡との複 合装置。

【請求項14】前記プローブが、複数のプローブであり、前記光強度検出手段が該複数プローブの微小開口を通った光をそれぞれ独立に検出する複数の光強度検出手段であることを特徴とする請求項12に記載の走査型近接場光顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡との複合装置。

【請求項15】プローブと、該プローブ先端におもて面を対向して配置された記録媒体と、 該記録媒体面内で該対向方向と垂直な方向に該プローブと該記録媒体とを相対移動させる手段と、該プローブ先端と該記録媒体の間に電圧を印加して情報の記録を行う手段と、該記録媒体の裏面に光を照射する手段と、該プローブの微小開口を通った光の強度を検出する手段と、該検出光強度をもとに情報の再生を行う手段とを有する記録再生装置において、

前記プローブが請求項6に記載のプローブで構成されていることを特徴とする走査型近接場光顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡との複合装置。

【請求項16】前記光強度検出手段が、前記プローブの 微小開口の背後に位置するよう該プローブを支持する部 材と一体構成されていることを特徴とする請求項15に 記載の記録再生装置。

【請求項17】前記プローブが、複数のプローブであり、前記光強度検出手段が該複数プローブの微小開口を

2

3

通った光をそれぞれ独立に検出する複数の光強度検出手 段であることを特徴とする請求項15に記載の記録再生 装置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、走査型近接場光顕 微鏡およびその原理を応用した情報記録再生装置等にお ける微小開口を有するプローブの作製法とそれによるプ ローブ、並びに該プローブを用いた走査型近接場光顕微 鏡と走査型トンネル顕微鏡との複合装置、および該プロ ーブを用いた記録再生装置に関する。

【従来の技術】近年、ナノメートル以下の分解能で導電

#### [0002]

性物質表面を観察可能な走査型トンネル顕微鏡(以下S TMと略す) が開発され (米国特許第4, 343, 99 3号明細書)、金属・半導体表面の原子配列、有機分子 の配向等の観察が原子・分子スケールでなされている。 また、STM技術を発展させ、絶縁物質等の表面をST Mと同様の分解能で観察可能な原子間力顕微鏡(以下A FMと略す) も開発された (米国特許第4, 724, 3 18号明細書)。また、STMを発展させたものとし て、尖鋭なプローブ先端の微小開口からしみ出すエバネ ッセント光を利用して試料表面状態を調べる走査型近接 場光顕微鏡(以下SNOMと略す) [Durig他, J. Appl. Phys. <u>59</u>, 3318 (198 6)]が開発された。さらに、試料裏面からプリズムを 介して全反射の条件で光を入射させ、試料表面へしみ出 すエバネッセント光を試料表面から光プローブで検出し て試料表面を調べるSNOMの一種であるフォトンST M (以下PSTMと略す) [Reddick他, Phy

s. Rev. B39, 767 (1989)]も開発され

【0003】さて、上記のSNOMにおいては、光プローブの先端径が分解能を決定するため、これまで種々の光プローブの作製方法が工夫されてきた。例えば、PSTMでは光プローブの先端に微小開口を設けず、光プローブとして用いる光ファイバー端面の化学エッチング条件を最適化することにより先端を尖鋭化し、分解能を向上させてきた。また、初期のSNOMにおいては、透明結晶の劈開面の交点を金属でコーティングし、これを固い面に押しつけ交点部分の金属を除去して交点を露出させ微小開口を作製した(欧州特許EP0112402号)。その後、微小開口をリングラフィーの手法を用いて作製する方法も用いられている。また、微小開口と光導波路を一体構成して光プローブを作製する方法も提案されている(米国特許第5,354,985号明細書)。

# [0004]

た。

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来例のうち、PSTMの場合のように光プローブに微小開口

4

を用いない場合、試料表面の凹凸による散乱光等エバネ ッセント光以外の迷光を検出してしまい、分解能が低下 してしまうという問題が生じる。また、光ファイバーを エッチングする方法では、光プローブを集積化・小型化 して作製することが困難である。そして、また、従来の 微小開口の形成方法のうち、結晶劈開面を利用する方法 では、微小開口径の大きさにばらつきが生じやすく、歩 留まりも良好でなく、また、集積化・小型化することも 難しかった。また、フォトリソグラフィーを用いた微小 開口形成方法においては、加工装置の精度の限界から、 100 [nm] 程度の直径の開口が限界で、10 [n m] 程度の直径の微小開口を作製することが難しかっ た。したがって、SNOM装置としての分解能に限界を 生じた。また、工程も複雑になってしまい、時間も要し コスト的にも高価になるという問題点があった。EB加 工装置やFIB加工装置を用いれば、100[nm]以 下の開口形成も原理的には可能であるが、位置合わせ制 御も複雑で、ばらつきが生じやすく、かつ、一点一点の 加工法であるため歩留まりがよくなかった。

20 【0005】そこで、本発明は、上記従来技術における 課題を解決し、大きさにばらつきがなく、歩留まりも良 好な微小開口が短時間で容易に形成でき、集積化・小型 化が可能で分解能が良好な微小開口を有するプローブの 作製法とそれによるプローブ、並びに該プローブを用い た走査型近接場光顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡との複 合装置、および該プローブを用いた記録再生装置を提供 することを目的としている。

## [0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解 決するため、微小開口を有するプローブの作製法とそれ 30 によるプローブ、並びに該プローブを用いた走査型近接 場光顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡との複合装置、およ び該プローブを用いた記録再生装置をつぎのように構成 している。すなわち、本発明のプローブの作製法は、導 電性材料でコーティングしたプローブ先端を導電性基板 に接触させ、該コーティングされたプローブと該基板と の間に電圧を印加し、該プローブ先端のコーティング材 料を除去し微小開口を形成することにより、微小開口を 有するプローブを作製するようにしている。さらに、前 40 記プローブが弾性体からなるようにし、または、弾性体 に支持されるようにし、該弾性体を弾性変形させて該プ ロープ先端と前記基板との間に作用する力を制御するよ うにしている。さらに、複数の前記プローブ先端を同時 に前記基板に接触させ、該複数のプローブ先端に同時に 微小開口を形成するようにしている。

【0007】上述の方法で作製した微小開口を有するプローブは、光学的に透明な材料からなる探針と、該探針先端に直径100[nm]以下の大きさの微小開口を有し、かつ該探針先端と逆側に該微小開口の直径より大きい直径の開口を有する導電性コーティング薄膜と、該探

20

5

針を支持する弾性体とから構成されている。さらに、探針先端に導電性を持たせるため、前記微小開口を光学的に透明かつ導電性を有する材料で覆うようにしている。前記光学的に透明かつ導電性を有する材料として、例えばITO・ポリジアセチレンを用いている。

【0008】また、走査型近接場光顕微鏡において、上 記に記載のプローブと、該プローブ先端におもて面を対 向して配置された試料と、該試料の裏面に光を照射する 手段と、該プローブの微小開口を通った光の強度を検出 する手段と、該試料面内で該対向方向と垂直な方向に該 プローブと該試料とを相対移動させる手段とを有するよ うにし、測定分解能を向上させている。また、上記に記 載の導電性を有するプローブと、該プローブ先端におも て面を対向して配置された試料と、該試料の裏面に光を 照射する手段と、該プローブの微小開口を通った光の強 度を検出する手段と、該プローブ先端と該試料との間に 流れる電流を検出する手段と、該試料面内で該対向方向 と垂直な方向に該プローブと該試料とを相対移動させる 手段とを有するようにし、測定分解能を向上させた走査 型近接場光顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡との複合装置 を実現している。

【0009】また、記録再生装置において、上記に記載の導電性を有するプローブと、該プローブ先端におもて面を対向して配置された記録媒体と、該記録媒体面内で該対向方向と垂直な方向に該プローブと該記録媒体とを相対移動させる手段と、該プローブ先端と該記録媒体の間に電圧を印加して情報の記録を行う手段と、該記録媒体の裏面に光を照射する手段と、該プローブの微小開口を通った光の強度を検出する手段と、該検出光強度をもとに情報の再生を行う手段と、を有するようにし、再生精度を向上させている。

【0010】さらに、前記の走査型近接場光顕微鏡、走査型近接場光顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡との複合装置、記録再生装置において、前記光強度検出手段が前記プローブの微小開口の背後に位置するよう該プローブを支持する部材と一体構成し、光検出分解能を低下させることなく、光強度検出手段との集積化を可能としている。

【0011】さらに、前記の走査型近接場光顕微鏡、走査型近接場光顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡との複合装置、記録再生装置において、前記プローブを複数のプローブとし、前記光強度検出手段が該複数プローブの微小開口を通った光をそれぞれ独立に検出する複数の光強度検出手段であるようにし、大面積の試料表面の高速測定、または、大容量情報の高速記録再生ができるようにしている。

# [0012]

【発明の実施の形態】本発明は、上記プローブの作製法 により、大きさにばらつきがなく、歩留まりも良好な微 小開口が短時間で容易に形成でき、集積化・小型化が可 能なプローブを実現することができる。そしてこの作製法によるプローブを用いて走査型近接場光顕微鏡および走査型近接場光顕微鏡とむ複合装置を構成することにより、測定分解能を向上させることができ、また記録再生装置を構成することにより、再生精度の向上を図ることができ、その複数プローブによるマルチ化によって大容量情報の高速記録再生を実現することが可能となる。

#### [0013]

【実施例】以下に、本発明の実施例を図に基づいて説明 する。図1~図3は、本発明の微小開口を有するプロー ブの作製法を示すものである。まず、このプローブの作 製法について、図3を用いて先端部分が金属コーティン グされた探針を有する弾性体カンチレバーの作製法を説 明する。図3 a に示すように、面方位(100)を有す るSi基板301に対して5[μm]四方の矩形部分を 除いたSiO2マスク303を施し、KOH溶液で異方 性エッチングを行い、ピラミッド型の溝302を形成す る。次に、図3bに示すようにスパッタ法で膜厚0.1 [μm]のPt膜304を形成後、探針先端コート部分 305および電極配線306をパターニングする。その 後、低圧CVDで1 [μm] 膜厚のSi3N4膜307を 形成後、カンチレバー形状にパターニングする。さら に、図3cに示すようにカンチレバーを支持するために ガラス基板308を陽極接合する。最後に、図3dに示 すように、KOH溶液でSi基板を除去し、Ptでコー ティングされた探針先端309を有する弾性体カンチレ バー310を形成する。

【0014】以上のように作製された金属コート探針を 有するカンチレバーに対して、微小開口を作製する方法 (断面図)を図1に示す。図2は図1に対応する平面図 である。図1a、2aにおいて、101は先端が尖鋭な 探針部分、102は弾性体レバー、103は金属コーティングである。金属で覆われた探針部分108を金属基板105に接触させ、電圧印加手段106で電極配線1 04を通し、探針部分108と金属基板105との間に 電圧を印加する。これにより、探針先端部分のコーティング金属膜を電界蒸発あるいは熱溶融により除去し、微 小開口が形成される。

40 【0015】ここで、(1)探針先端径、(2)コーティング金属の膜厚、(3)金属基板に対する探針先端の接触力、(4)印加電圧条件、をそれぞれ制御することにより、コーティング金属膜の除去の程度、すなわち微小開口の径を制御することができる。探針先端径が小さければ、金属基板に対する探針先端の接触面積が小さくなり、電圧印加の際に電界の加わる領域や電流の流れる領域が集中するため、コーティング金属膜の除去される領域が小さくなる。探針先端径を小さくするためには、尖鋭化処理により探針そのものを尖鋭化するほか、コーティング金属膜の形成時に金属表面が荒くなるような形

10~100 [nm] の範囲であった。上記のように作 製した微小開口を有するプローブは探針先端のコーティ ング金属が除去されているため、探針先端は導電性を有 していない。したがって、探針先端に導電性を必要とす

るような装置に用いる場合には図4に示すようにスパッ タ法等により I TO等の透明導電性材料を探針先端近傍 にコーティングすればよい。他にも、LB法によりポリ

ジアセチレン等の導電性材料の単分子累積膜を探針先端 近傍に成膜してもよい。

【0017】また、上記の微小開口を有するプローブの 10 作製法は、特に複数のプローブに対して同時に微小開口 を作製するのに適した方法である。図5に示すように複 数のプローブ502、503、504の探針先端を金属 基板501に対して接触させ、電圧印加手段505を用 い、複数の探針-金属基板間に電圧を印加する。これに より、複数の開口を同時作製することができる。ここ で、複数のプローブは弾性体カンチレバーで構成されて いるため、複数プローブの作製プロセス時の誤差等によ って生じる金属基板表面を基準とした探針先端の図中 z 方向の位置ばらつきがあっても、探針先端と金属基板の 20 間の接触力の大きさをある値以下にした状態で、探針先 端がすべて金属基板表面に接触した状態にすることがで きる。例えば、弾性体カンチレバーの弾性定数をk、複 数プローブの作製プロセス時の誤差等によって生じる金 属基板表面を基準とした探針先端の α 方向位置ばらつき の最大量を△z'とすると、すべての探針先端が金属基 板表面に接触した状態の接触力のばらつきはk△z'と なるため、複数プローブの支持部材506と試料501 のz方向位置を制御することにより、すべての探針先端

【0018】電圧印加の方法としては、デマルチプレク サを用い、複数のプローブに対して順次電圧印加を行 い、微小開口を順番に作製すればよい。しかしながら、 この場合は微小開口形成に時間を要することになる。こ の点を改良するためには、金属基板501と複数プロー ブの支持部材506とを金属基板表面に平行な面内方向 に相対的に移動させながら電圧印加を行えばよい。これ により、一部のプローブにおける開口作製時に探針先端 から除去されたコーティング金属材料が探針先端と金属 材料との間に挟まり、探針先端と金属基板間が導通状態 (=低抵抗化)になって、他のプローブにおいて印加電 圧値が低下し、微小開口形成が行われなくなることを避 けることができ、複数プローブにおいて同時に微小開口 形成が行われる。

が金属基板表面に接触した状態で、すべての接触力の大

きさをk△2,以下にすることができる。

【0019】さて、上述のようにして作製したプローブ を応用した例を以下に説明する。図6は本発明のプロー ブを複数用い、マルチSNOMを構成した例である。図 6において、601、602、603は本発明のプロー 50 ブを用いたSNOMプローブ1、2、3である。複数の

成法や金属材料を選択すればよい。前述の弾性体カンチ レバー形成法における具体例をあげると、異方性エッチ ングによるピラミッド型溝を形成後、低温熱酸化を行う ことにより、ピラミッド型溝の先端(底)を尖鋭化する ことができる。また、Pt膜を成膜する場合にも蒸着法 よりもスパッタ法を選択すれば、Pt膜を形成するPt 粒が細かくなり、コーティングされた探針先端を尖鋭化 することができる。コーティング金属膜の膜厚が小さけ れば、探針先端径が小さい場合と同様、電圧印加の際に 電界の加わる領域や電流の流れる領域が集中するため、 コーティング金属膜の除去される領域が小さくなる。し かしながら、作製法にもよるが金属膜の膜厚を100 [nm] より小さくすると、連続膜となりにくくなる傾 向がある。これでは本発明のプローブには適さないた め、金属膜の膜厚は100 [nm] 程度が望ましい。ま た、接触力が小さければ、金属基板に対する探針先端の 接触面積が小さくなり、やはりコーティング金属膜の除 去される領域が小さくなる。接触力を小さくするために は、以下のようにすればよい。弾性体カンチレバー10 2を弾性変形させることにより、金属で覆われた探針部 分108と金属基板105との接触力を所望の値に制御 することができる。例えば、弾性体カンチレバー102 の弾性変形に関する探針部分位置換算の弾性定数をkと すると、金属基板105に対する接触による探針部分位 置換算の弾性体カンチレバー102の弾性変形量を△z 以下にすることにより、接触力をk△z以下にすること ができる。さらに、印加電圧の波高、波形、時間幅、負 荷抵抗を調節することにより、探針先端に加わる電界お よび探針-金属基板間に流れる電流の大きさ、時間的変 化を制御することができ、これによりコーティング金属 膜の除去の程度を制御することができる。実際に、金属 コーティング材料がPtで先端径が20[nm]である 探針を有し、弾性定数が0.1 [N/m] の弾性体カン チレバーの弾性変形量を1 [μm]以下に、すなわち接 触力を10<sup>7</sup>[N]以下に制御した状態でAu金属基板 に接触させて、波高値:10 [V]、波形:矩形波、時 間幅:100 [μs]、負荷抵抗:1 [MΩ] の電圧を 印加したところ、微小開口の径が約10[nm]となっ

【0016】本発明の微小開口形成方法では、上述の

(1)探針先端径、(2)コーティング金属の膜厚、

た。

(3) 金属基板に対する探針先端の接触力、(4) 印加 電圧条件を変えることにより、微小開口径を3~100 0 [nm] の範囲で制御することができた。ただし、1 00 [nm] 以上の径の開口作製の場合は電圧印加条 件、接触力条件等の形成条件が過激となるためか、開口 の形状が不安定になりがちで、探針先端の破壊が伴なう こともあり、本発明のプローブとしてはあまり好ましく ない。また、10[nm]以下では、再現性が良くない こともあり、安定に開口を形成することができるのは約

20

30

10

SNOMプローブ1、2、3はプローブ支持部材604に一体構成で作製されている。また、表面にアバランシェフォトダイオード等、高感度の複数のフォトダイオード1(605)、2(606)、3(607)を作製したフォトダイオード支持部材608がプローブ支持部材604に張り合わされて一体化している。このときフォトダイオード1~3(605~607)の位置は、対応するSNOMプローブ1~3(601~603)の微小開口の背後(=図中、上部)になるよう設計、作製されている。

【0020】本発明のプローブでは、探針の微小開口と 逆側には金属コーティングがないため、微小開口径より も大きな(~数μm) 開口を有している。このため、微 小開口の背後にスペースをとることができ、光導波路等 を用いることなく、フォトダイオード等光検出機構を近 傍に配置することができるため、光検出分解能を低下さ せることのない光検出機構との一体集積化が可能となっ た。被測定試料609は透明基板610上に設けられて いる。透明基板610を通して試料609の背後から試 料609の表面において全反射の条件になるような角度 で光611を入射する。このとき、光は試料609表面 から図中、上方向に透過しないが、試料609表面から の距離が 0. 1 [μm]以下のごく近傍にはエバネッセ ント光と呼ばれる光がにじみ出している。このとき、複 数のSNOMプローブ1~3 (601~603) の探針 先端が試料に接触するように配置すると、このエバネッ セント光1 (612)、2 (613)、3 (614)が SNOMプローブの微小開口を通って背後のフォトダイ オード1~3 (605~607) で検出される。検出さ れたエバネッセント光電流信号をI/V変換回路1(6 15)、2(616)、3(617)で電圧信号に変換 し、マルチプレクサ618においてマルチSNOM信号 とする。

【0021】ここで、複数のSNOMプローブは弾性体 カンチレバーで構成されているため、試料に対し、探針 先端がすべて接触した状態で、かつ、探針先端と試料の 間の接触力の大きさをある値以下にすることができる。 例えば、弾性体カンチレバーの弾性定数をk、複数SN OMプローブの作製プロセス時の誤差等によって生じる 試料表面を基準とした探針先端の z 方向位置ばらつきの 最大量を△z"とすると、すべての探針先端が試料表面 に接触した状態の接触力のばらつきはk△z"となるた め、プロープ支持部材604と試料609のz方向位置 を制御することにより、すべての接触力の大きさを k △ z"以下にすることができる。これにより、大きな接触 力が加わることによる探針先端の破壊や試料の破壊を避 けることができる。図中、不図示であるがxyアクチュ エータを用い、複数SNOMプローブ1~3に対し試料 609を試料面内方向(図中xy方向)に2次元の相対 走査を行い、xy面内の各位置におけるSNOM信号の 大きさをプロットすることにより、試料609表面のS NOM観測像が得られる。

【0022】図7は本発明の導電性を有するプローブを 用い、マルチSNOM/STMを構成した例である。図 7において、701~703はそれぞれ導電性SNOM プローブ1~3、704はプローブ支持部材、705~ 707はフォトダイオード1~3、708はフォトダイ オード支持部材、709は試料、710は透明基板、7 11は光、712~714はエバネッセント光1~3、 715~717はI/V変換回路1~3、718はマル チプレクサ1である。これらの構成および機能、動作に 関しては図6の説明と同様である。異なる点として、透 明基板710上にITO等の透明導電性材料からできた 透明電極719が設けられ、試料709は透明電極71 9上に構成されている。透明電極719はバイアス電圧 印加手段720に接続され、バイアス電圧が印加されて いる。導電性SNOMプローブ1~3 (701~70 3) の探針先端と透明電極719の間、すなわち、探針 先端の接触部分の試料中を流れる電流を I / V変換回路 1'(721)、2'(722)、3'(723)で電 圧信号に変換し、マルチプレクサ2 (724) において マルチSTM信号とする。SNOM信号と同時に、2次 元の相対走査中のxy面内の各位置におけるSTM信号 の大きさをプロットすることにより、試料709表面の SNOM/STM同時観測像が得られる。

【0023】図8は本発明のプローブを複数用い、記録 再生装置を構成した例である。図8において、801、 802、803は本発明の導電性を有するプローブを用 いた記録再生プローブ1、2、3である。複数の記録再 生プローブ1、2、3はプローブ支持部材804に一体 構成で作製されている。また、表面にアバランシェフォ トダイオード等、高感度の複数のフォトダイオード1 (805)、2(806)、3(807)を作製したフ ォトダイオード支持部材808がプローブ支持部材80 4に張り合わされて一体化している。このときフォトダ イオード1~3 (805~807) の位置は、対応する 記録再生プローブ1~3 (801~803)の微小開口 の背後 (=図中、上部) になるよう設計、作製されてい る。記録媒体809は透明基板810上の透明電極81 9上に設けられている。複数の記録再生プローブ1~3 (801~803) の探針先端は記録媒体809表面に 接触するように配置されている。情報の記録電圧信号が デマルチプレクサ820において分割され、各記録再生 プローブ1~3 (801~803) の導電性探針に印加 され、記録媒体809の導電性探針が局所的に接触して いる部分に記録が行われる。ここで、記録媒体809と しては、後述のように電圧印加あるいは電界印加、電流 を流すことにより光学的特性が変化するような材料を用 いる。

50 【0024】さて、以上のように記録された情報の再生

20

方法を以下に説明する。透明基板810を通して記録媒

形成し、電界印加によりこのレドックス・ペア間でプロトン移動を起こすようなキノン基およびヒドロキノン基を有するアゾ化合物が挙げられる。

[0026]

【発明の効果】以上による本発明のプローブの作製法 は、形成方法が単純で複雑な工程を経ることもないた め、微小開口形成プロセスが短時間で、大きさにばらつ きがなく、歩留まりの良好な微小開口が形成でき、コス トの低減化が図れ、集積化・小型化が可能なプローブを 容易に実現することができる。そして、本発明のプロー プの作製法における金属コーティングされた探針を金属 材料に接触させ、電圧印加により探針先端のコーティン グ金属を除去する微小開口形成方法によると、直径10 [nm] 程度の微小開口が作製できるので、これをSN OMや記録再生装置に用いることにより、測定分解能や 再生精度を向上することが可能となる。また、本発明の プローブの作製法は、上記したように小型化、集積化に 適した方法であるので、これを用いることにより小型の SNOMや記録再生装置、複数の光プローブを有するS NOMや記録再生装置を容易に実現することができる。 また、本発明のプローブにおいて、微小開口を有する探 針先端面に対する該探針の逆側面には導電性コーティン グ薄膜を形成しないように構成することにより、微小開 口の背後にスペースをとることができ、フォトダイオー ド等光検出機構を配置し易くなり、光検出分解能を低下

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の微小開口を作製する方法の説明図(断面図)である。

させることなく光検出機構との集積化が可能となる。

30 【図2】図2は、本発明の微小開口を作製する方法の説明図であり、図2(a)は図1(a)の平面図、図2(b)は図1(c)の平面図である。

【図3】金属コーティングされた探針を有する弾性体カンチレバーの作製法の説明図である。

【図4】 導電性探針を有するプローブの構成図である。

【図5】複数のプローブにおける複数の微小開口を同時 作製する方法の説明図である。

【図6】本発明のプローブを複数用いたマルチSNOM の構成図である。

40 【図7】本発明の導電性を有するプローブを用いたマル チSNOM/STMの構成図であるる

【図8】本発明のプローブを複数用いた記録再生装置の 構成図であるる

【符号の説明】

101:探針部分

102:弾性体カンチレバー

103:金属コーティング

104:電極配線

105:金属基板

50 106: 電圧印加手段

体809の背後から記録媒体809の表面において全反 射の条件になるような角度で光811を入射させる。こ のとき、光は記録媒体809表面から図中、上方向に透 過しないが、記録媒体809表面からの距離が0.1 [μm]以下のごく近傍にはエバネッセント光と呼ばれ る光がにじみ出している。このとき、このエバネッセン ト光1 (812)、2 (813)、3 (814) が記録 再生プローブの微小開口を通って背後のフォトダイオー ド1~3 (805~807) で検出される。検出された エバネッセント光電流信号を I/V変換回路1(81 5) 、2 (816) 、3 (817) で電圧信号に変換 後、マルチプレクサ818において合成し、再生信号と する。ここで、複数の記録再生プローブは弾性体カンチ レバーで構成されているため、記録媒体に対し、探針先 端がすべて接触した状態で、かつ、探針先端と記録媒体 の間の接触力の大きさをある値以下にすることができ る。例えば、弾性体カンチレバーの弾性定数をk、複数 記録再生プローブの作製プロセス時の誤差等によって生 じる記録媒体表面を基準とした探針先端のz方向位置ば らつきの最大量を△z"とすると、すべての探針先端が 記録媒体表面に接触した状態の接触力のばらつきはk△ z"となるため、プローブ支持部材804と記録媒体8 09のz方向位置を制御することにより、すべての接触 力の大きさをk△z"以下にすることができる。これに より、大きな接触力が加わることによる探針先端の破壊

【0025】図中、不図示であるがxyアクチュエータ を用い、複数記録再生プローブ1~3に対し記録媒体8 09を記録媒体面内方向(図中xy方向)に2次元の相 対走査を行い、x y 面内の所定の位置において記録再生 を行う。本実施例では、特に微小開口を有する複数の記 録再生プローブで記録再生動作を行なうため、記録媒体 に対し、高密度かつ高速の記録再生動作が可能な記録再 生装置が実現されるという効果を有する。また、本実施 例では電圧印加により記録を行う例を示したが、本実施 例の構成では、光を照射した状態で電圧印加を行うこと も可能である。このような場合、記録媒体として光照射 下で電圧印加を行うことにより記録が行われるものを用 いればよい。本実施例の記録再生装置において用いられ る記録媒体としては、電圧印加により光学特性が変化す る記録媒体の例として、特開平4-90152号公報に 記載されているような電圧印加により、局所的に流れる 電流によるジュール熱によりジアセチレン誘導体重合体 に構造変化が起こり、光の吸収帯のピーク波長がシフト するような10、12-ペンタコサジイン酸が挙げられ る。また、光照射下の電圧印加により光学特性が変化す る記録媒体の例として、特開平2-98849号公報に 記載されているような光を照射した場合のみシス型←→ トランス型の光異性反応を起こしてレドックス・ペアを

や記録媒体の破壊を避けることができる。

13 107:微小開口 \*705:フォトダイオード1 706:フォトダイオード2 108:金属で覆われた探針部分 301:面方位(100) Si基板 707:フォトダイオード3 708:フォトダイオード支持部材 302:ピラミッド型溝 303:SiO2マスク 709:試料 710:透明基板 304:Pt膜 711:光 305:探針先端コート部分 306:電極配線 712:エパネッセント光1 307:Si3N4膜 713:エバネッセント光2 308:ガラス基板 10 714:エバネッセント光3 309:金属でコーティングされた部分 715: I/V変換回路1 310:カンチレバー 716: I/V変換回路2 501:金属基板 717: I/V変換回路3 502:プローブ1 718:マルチプレクサ1 503:プローブ2 719:透明電極 504:プローブ3 720:バイアス電圧印加手段 721: I/V変換回路1' 505: 電圧印加手段 722: I/V変換回路2' 506:複数プローブの支持部材 723: I/V変換回路3' 601:SNOMプローブ1 602:SNOMプローブ2 20 724:マルチプレクサ2 603:SNOMプローブ3 801: 記録再生プローブ1 604:プローブ支持部材 802: 記録再生プローブ2 605:フォトダイオード1 803: 記録再生プローブ3 804:プローブ支持部材 606:フォトダイオード2 607:フォトダイオード3 805:フォトダイオード1 806:フォトダイオード2 608:フォトダイオード支持部材 609:試料 807:フォトダイオード3 6 1 0:透明基板 808:フォトダイオード支持部材 809: 記録媒体 611:光 612:エバネッセント光1 30 810:透明基板 613:エバネッセント光2 811:光 614:エバネッセント光3 812:エバネッセント光1 813:エバネッセント光2 615: I/V変換回路1 616: I/V変換回路2

617: I/V変換回路3

704:プローブ支持部材

701: 導電性 SNOM プローブ1

702: 導電性 SNOM プロープ 2

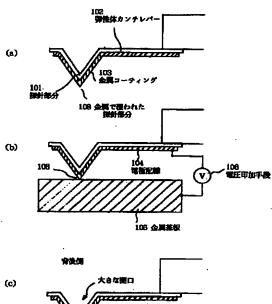
703: 導電性 SNOM プローブ3

618:マルチプレクサ

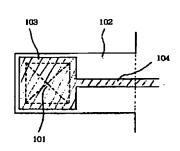
814:エバネッセント光3 815: I/V変換回路1 816: I/V変換回路2 817: I/V変換回路3 818:マルチプレクサ

8 1 9: 透明電極 \*40 820: デマルチプレクサ

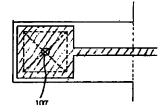
【図1】



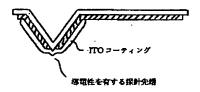
【図2】



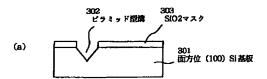
Joseph Company of the Company of the

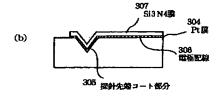


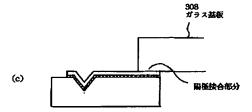
[図4]

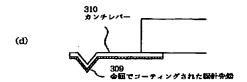


【図3】

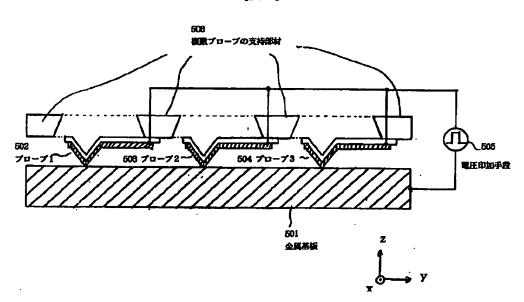




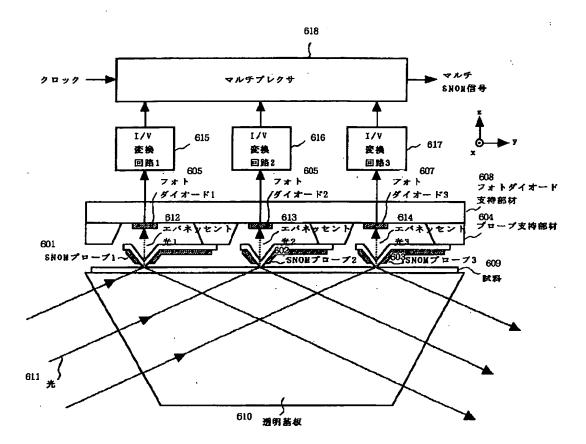




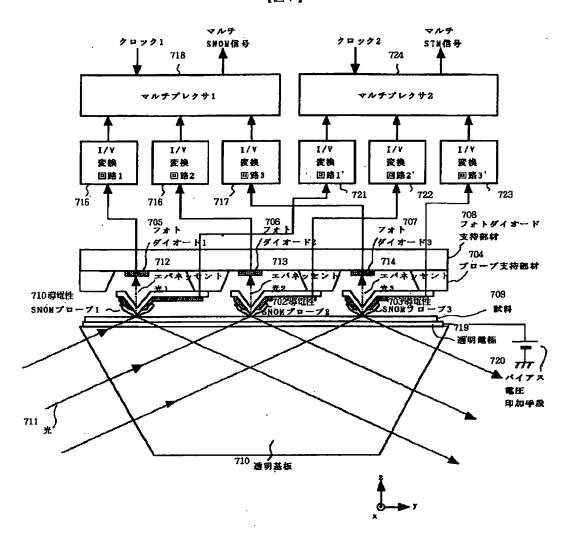
【図5】



【図6】



【図7】



【図8】

